

Micron Technology 發運首批混合式內存立方樣品

計畫 2014 年開始批量生產

愛達荷州博伊西，2013 年 9 月 23 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Micron Technology, Inc.（納斯達克股票代碼：MU），宣佈發運 2GB 混合式內存立方（HMC）工程樣品。HMC 代表了記憶體技術上的一次巨大進步，這些工程樣品是全球首款供眾多領先客戶分享的 HMC 設備。HMC 專用于需要高頻寬記憶體存取的應用，包括資料包處理、資料包緩衝或存儲以及計算應用程式，如處理器加速等。Micron 預計在三至五年內將下一代 HMC 遷移到消費類應用中。

本新聞稿所附的照片位於 <http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=21136>

業內一次重大突破，HMC 採用先進的直通矽晶穿孔技術（TSV）-- 使用垂直管道電連接一個獨立的晶片堆疊 -- 將高性能邏輯和 Micron 先進的 DRAM 相結合。Micron 的 HMC 具有一個容量為 2GB 的存儲立方，該立方由四片容量為 4GB 的 DRAM 堆疊而成。該解決方案提供了前所未有的 160GB/秒的記憶體頻寬，但其每位元組能耗卻比現有技術減少 70% 以上，顯著降低了客戶的擁有權總成本（TCO）。

“混合式記憶體立方是一種巧妙的裝置，打破了業內過去採用的方法，並開創了一種新的可能，” Objective Analysis 記憶體分析師 Jim Handy 說到。“雖然 DRAM 的內部頻寬及其對資料的邏輯渴求已成指數地增加，但現有的處理器-記憶體頻寬是有限的，並且能耗非常高。HMC 是一種令人激動的替代方案。”

HMC 使記憶體抽象化，設計者可投入更多時間利用 HMC 的革命性功能和性能，減少花在實現基本功能所需的眾多記憶體參數上的時間。它還可管理糾錯、恢復、刷新和被記憶體處理變化加激的其他參數。

“系統設計師正在尋找可支援不斷增長的頻寬、密度和能效需求的新型記憶體系統，”Micron DRAM 解決方案集團副總裁 Brian Shirley 說到。“HMC 代表了記憶體性能的新標準，是我們的客戶一直期待的突破口。”

HMC 已被業界領導和權威人士視為期待已久的、用於填補 DRAM 性能改進率和處理器資料消耗率之間缺口的利器。Micron HMC 最近被主流電子出版物《EDN and EE Times》評為年度記憶體產品。

Micron 預計將在 2014 年初推出 4GB HMC 工程樣品，2014 年底批量生產 2GB 和 4GB HMC 設備。

關於 Micron

Micron Technology, Inc. 是全球領先的先進半導體解決方案供應商之一。通過它遍佈全球的運營，Micron 為先進的計算、使用者、網路、嵌入式和移動產品生產和銷售全套 DRAM、NAND 和 NOR 快閃記憶體，以及其他創新的記憶體技術、封裝方案和半導體系統。Micron 的普通股在納斯達克上市交易，代碼是 MU。欲瞭解有關 Micron Technology, Inc. 的更多資訊，請訪問 www.micron.com。

(C) 2013 Micron Technology, Inc. 版權所有。資訊如有修改恕不另行通知。Micron 和 Micron orbit 徽標是 Micron Technology, Inc. 商標或註冊商標。所有其他商標或服務標記分別為其各自所有者擁有。本新聞稿包含有關混合式記憶體立方的樣品可用性和批量生產的前瞻性陳述。請參考 Micron 和證券交易委員會定期發佈的匯總檔，特別是 Micron 最新的 10-K 和 10-Q 表。這些檔包含並確定導致匯總檔中的內容與前瞻性陳述不同的重要因素（見“某些因素”）。儘管我們認為前瞻性陳述中所反映的預期是合理的，但我們不能保證其未來結果、活動程度、性能或成就。

也可使用程式 PhotoExpress 查看照片。

聯繫方式：Micron 媒體連絡人：

Scott Stevens

Micron Technology, Inc.

+1-512-288-4050

ssstevens@micron.com